# 准粒子谱函数对单层石墨片最小电导率的影响\*

罗 涛 朱 伟 石勤伟† 王晓平

(中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室,合肥 230026) (2007年10月17日收到2007年11月15日收到修改稿)

在有效质量近似下 利用久保(Kubo)公式计算了单层石墨片的最小电导率.结果发现最小电导率的大小依赖 于准粒子谱函数的函数形式 如果准粒子谱函数取洛伦兹分布 得到最小电导率为 4e<sup>2</sup>/πh 如果准粒子谱函数满足 高斯分布 则最小电导率为 2e<sup>2</sup>/h.

关键词:单层石墨片,最小电导率,久保公式 PACC:7125X,7280R

### 1.引 言

自 2004 年英国曼彻斯特大学 Geim 小组成功地 剥离出单层石墨片以来 这种只有一个原子层厚度 的理想二维体系显示了不同寻常的奇异特性,已成 为当前凝聚态物理研究的热点之一,实验上已经发 现该体系具有很多新颖的物理性质 :例如 强磁场下 反常的量子霍耳效应[1]、反弱局域化[2]、弹道输 运<sup>[34]</sup>、Josephson效应<sup>[5]</sup>、双极性超导特性<sup>[6]</sup>等.理论 上 单层石墨片独特的电子结构和无质量费米子的 特征 使得人们可以利用低能的凝聚态物理来模拟 一些量子场论所预言的相对论量子现象[134],例如 克莱因佯谬 Klein paradox )<sup>71</sup>.人们还研究了单层石 墨片条带,解析地给出了锯齿形(zigzag)条带和扶手 椅形( armchair )条带的本征能量和本征波函数<sup>[89]</sup>, 并以石墨条带设计和构筑量子点器件等<sup>10]</sup>.这些研 究工作与进一步完善的微纳加工技术相结合,例如 在钉(Ru)表面上制备单层石墨片[11],有望实现基于 单层石墨片的全碳集成电路,预示着这种材料具有 潜在的广阔应用前景.

对于单层石墨片这一标准的二维体系,根据单 参数标度理论的预言<sup>[12]</sup>,其最小电导率在极低温度 下应该是连续地趋于零.然而,实验上观察到单层石 墨片电导率随着门电压(或载流子浓度)的变化,存 在一个相对稳定的极小值(即最小电导率)约为  $4e^2/h^{[3,4]}$ .因此,如何理解该体系存在普适的最小电导率引起了理论物理学家的广泛兴趣.计算单层石 墨片最小电导率最常见的方法是利用久保公式,但 迄今发表的计算结果仍存在一定的差异.例如, Katsnelson<sup>[13]</sup>,Castro Neto<sup>[14]</sup>,Gusynin 和 Sharapov<sup>[15]</sup>, Zheng 和 Ando<sup>[16]</sup>等得到的结果为  $4e^2/\pi h$ ,而 Csert<sup>[17]</sup>和 Ziegler<sup>[18]</sup>的结果则分别为  $\pi e^2/2h$  和  $\pi e^2/h$ .此外 Ziegler 发现最小电导率取值依赖于不 同的极限过程,因而不是普适的<sup>[19]</sup>.Nomura<sup>[20]</sup>发现 在考虑库仑长程散射情况下,单层石墨片最小电导 率的数值计算与文献 3 的实验结果基本符合.

最近针对单层石墨片最小电导率的进一步实验 测量表明 最小电导率的大小依赖于电子的输运方 式 ,即弹道输运还是扩散输运<sup>[21]</sup>.在弹道区 ,最小电 导率与样品的尺度有关 ,仅对短而宽的样品其最小 电导率才约为 4*e*<sup>2</sup>/π*h* ;而在扩散区 ,最小电导率不 依赖于样品的尺寸 ,因而是普适的 ,它的取值是弹道 区的四倍左右.

上述研究表明,单层石墨片最小电导率的物理 起因尚未完全阐明,因此值得我们做进一步研究.我 们注意到,已发表的理论工作均是采用洛伦兹分布 来描述准粒子的谱函数.但值得指出的是:在传统的 二维电子气中,若考虑杂质屏蔽的长程库仑势散射, 理论推导的结果表明准粒子谱函数的形式在外加磁 场下应是高斯分布,它比用洛伦兹分布描述准粒子 谱函数更加符合实验结果<sup>221</sup>.这提示我们在研究单

<sup>\*</sup>国家自然科学基金(批准号:10574119,50121202)资助的课题.

<sup>†</sup> 通讯联系人. E-mail :phsqw@ustc.edu.cn

层石墨片最小电导率时,是否也可以使用高斯分布 来描述准粒子谱函数,同时也考察准粒子谱函数的 形式对最小电导率的大小是否存在影响.

本文分别采用洛伦兹分布和高斯分布描述准粒 子谱函数,在外加磁场情况下利用久保公式计算了 单层石墨片的最小电导率.结果发现.洛伦兹分布时 得到的最小电导率是 4e<sup>2</sup>/πh,并且与外加磁场的强 弱无关;而高斯分布时最小电导率与外加磁场有关, 其在外磁场趋于零时的数值为 2e<sup>2</sup>/h.这一结果表 明最小电导率的数值与准粒子满足的谱函数形式密 切相关.

#### 2. 计算方法与结果

从久保公式出发 交流电导率  $\sigma_{xx}$  可表示为<sup>[23]</sup>

$$\sigma_{xx} = \frac{e^2 \hbar}{\pi L_x L_y} \int_{-\infty}^{+\infty} dE \frac{f(E) - f(E + \hbar\omega)}{\hbar\omega}$$

× tr{ $v_x \operatorname{Im} Q(E + \hbar\omega) v_x \operatorname{Im} Q(E)$ }, (1) 其中  $f(E) = \frac{1}{1 + \exp(\beta(E - E_F))}$ 是准粒子在温度 T时的费米分布函数  $\beta = 1/k_B T \cdot L_x$  和  $L_y$  是样品在 x轴和 y 轴方向的长度  $v_x$  为速度算符 ,由海森伯方 程得到  $v_x = \frac{i}{\hbar} [H, x]$ .其中  $\operatorname{Im} G(E) = -\pi \delta(E - H)$ .为了计算直流电导率 ,我们采用先取极限  $\omega \rightarrow 0$ 从而[ $f(E) - f(E + \hbar\omega)$ ] $\hbar\omega$  近似为  $-\partial f/$  $\partial E$ .在  $T \rightarrow O(\beta \rightarrow \infty)$ 时 ,直流电导率为

$$\sigma_{xx} = \frac{e^2 \hbar}{\pi L_x L_y} \operatorname{Tr}\{v_x \operatorname{Im} \mathcal{O}(E_F) v_x \operatorname{Im} \mathcal{O}(E_F)\}. \quad (2)$$

在单层石墨片上外加垂直的均匀磁场 B = ∇ × A,采用有效质量近似,其单电子哈密顿量为

 $H = v_{\rm F} \boldsymbol{\sigma} \cdot (\boldsymbol{p} + e\boldsymbol{A}),$  (3) 其中费米速度  $v_{\rm F} \approx 8 \times 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ,泡利矩阵  $\boldsymbol{\sigma} =$  $(\sigma_x, \sigma_y),动量算符 \boldsymbol{p} = -i\hbar(\partial x, \partial y)^T, \boldsymbol{A}$ 为磁矢 势.我们选择朗道规范  $\boldsymbol{A} = xB\hat{\boldsymbol{y}}$ ,得到能量本征值和 本征波函数为

$$E_{s,n} = sE_n = s\sqrt{2n\hbar\omega_c}, n = 0, 1, 2, 3, \dots$$
(4)

其中回旋频率  $\omega_{e} = \frac{v_{F}}{l_{e}}$ ,  $h\omega_{e}$  可以用来反映朗道能级 之间间隔的一种能量单位.我们注意到能量本征值  $E_{n}$  不是正比于 n 的,这一点与薛定谔方程所描述的 自由电子的朗道能级的性质是不同的. 当 n = 0 时 本征函数是

$$r + 0k_{y} = \frac{e^{ik_{y}y}}{\sqrt{L_{y}}} \begin{pmatrix} 0\\ \phi_{0,k_{y}} \end{pmatrix} ,$$
  
$$\phi_{0,k_{y}}(x) = \frac{1}{\sqrt{\sqrt{\pi}l_{c}}} \exp\left(-\frac{(x + l_{c}^{2}k_{y})^{2}}{2l_{c}^{2}}\right) .$$
(5a)

$$r + nk_{y-s} = \frac{e^{ik_{y}y}}{\sqrt{2L_{y}}} \begin{pmatrix} -is\phi_{n-1,k_{y}} \\ \phi_{n,k_{y}} \end{pmatrix},$$
  
$$\phi_{n,k_{y}}(x) = \frac{1}{\sqrt{2^{n}n \sqrt[3]{\pi l_{c}}}}$$
  
$$\times \exp\left(-\frac{(x+l_{c}^{2}k_{y})^{2}}{2l_{c}^{2}}\right)$$
  
$$\times H_{n}\left(\frac{x+l_{c}^{2}k_{y}}{l_{c}}\right), \qquad (5b)$$

其中  $s = \pm 1$  分别描述导带和价带  $H_n$  是 Hermite 多 项式 n 是描述朗道能级的量子数 ,量子数  $k_y = 2\pi m/L_y$ ( m 是整数 ,其取值范围受到  $L_x$  大小限制), 回旋半径  $l_x = \sqrt{\hbar/eB}$ .

由于狄拉克方程存在电子-空穴对称性,电中性 的单层石墨片的费米能级  $E_F$  是不依赖于磁场强度 的 始终钉扎在狄拉克点上,这里我们可以令  $E_F =$ 0 得到

$$s' n'k'_{y} + \operatorname{Im} G(E_{F}) + nk_{y} s$$

$$= \delta_{s',s} \delta_{n',n} \delta_{k'_{y},k'_{y}} (-\pi) \delta(E_{n}). \qquad (6)$$

由海森伯方程得到速度算符为

$$v_x = v_{\rm F} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{7}$$

当  $n' \ge 1$  和  $n \ge 1$  时,

$$s' n'k'_{y} + v_{x} + nk_{y} s$$

$$= \frac{v_{F}}{2} \delta_{k_{y},k'_{y}} (-is \delta_{n',n-1} + is' \delta_{n'-1,n}). \quad (8a)$$

当 n' = 0时,

$$0k'_{y} + v_{x} + nk_{y-s} = -is \frac{v_{F}}{\sqrt{2}} \delta_{k_{y},k'_{y}} \delta_{0,n-1}.$$
 (8b)

当 n = 0时,

$$s' n'k'_{y} + v_{x} + 0k_{y} = is' \frac{v_{\rm F}}{\sqrt{2}} \delta_{k_{y},k'_{y}} \delta_{n'-1,0}$$
. (8c)

在同一朗道能级上的简并度是  $L_x L_y / 2\pi l_e^2$ ,所以

$$\operatorname{Tr}\{v_{x}\operatorname{Im}\mathcal{A}(E_{\mathrm{F}})v_{x}\operatorname{Im}\mathcal{A}(E_{\mathrm{F}})\}$$
$$=\frac{L_{x}L_{y}}{2\pi l_{\mathrm{c}}^{2}}\sum_{n=1}^{2}2\pi^{2}v_{\mathrm{F}}^{2}\delta(E_{n})\delta(E_{n-1}).$$
(9)

在下面的计算过程中,我们分别采用洛伦兹分 布和高斯分布描述的准粒子谱函数来计算单层石墨 的最小电导率.

洛伦兹分布描述准粒子谱函数为  $\delta_{\eta}(\epsilon) = \eta/\pi(\epsilon^2 + \eta^2)$ 参数  $\eta$  的物理意义是电子受到杂质 散射、声子散射以及电子间库仑散射对自能修正虚 部的贡献.将洛伦兹分布带入(9)式得到

 $Tr\{v_x Im Q(E_F) v_x Im Q(E_F)\}$ 

$$=\frac{L_{x}L_{y}}{2\pi l_{c}^{2}}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2\eta^{2}v_{F}^{2}}{(2n(\hbar\omega_{c})^{2}+\eta^{2})(2(n-1)(\hbar\omega_{c})^{2}+\eta^{2})}.$$
(10)

利用求和公式 
$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{[p + (k-1)q](p + kq)} =$$

 $\frac{1}{pa}$ ,得到

$$\operatorname{Tr}\{v_{x} \operatorname{Im} \mathcal{A}(E_{F})v_{x} \operatorname{Im} \mathcal{A}(E_{F})\} = \frac{L_{x}L_{y}}{2\pi\hbar^{2}}.$$
 (11)

将上式代入直流电导(2)式计算

$$\sigma_{xx} = \frac{e^2 \hbar}{\pi L_x L_y} \cdot \frac{L_x L_y}{2\pi \hbar^2} = \frac{e^2}{\pi h}.$$
 (12)

如果考虑自旋和子格点简并,最小电导率要乘 以因子4,所以最后得到的最小电导率为4e<sup>2</sup>/πh,这 个结果与郑以松等人的结果一致<sup>[13-16,19]</sup>.

如果 将 高 斯 分 布 准 粒 子 谱 函 数  $\delta_{\eta}(\epsilon) =$   $\sqrt{1/2\pi\eta^2} \exp(-\epsilon^2/2\eta^2)$ 代入(9)式 得到  $\operatorname{Tr}\{v_x \operatorname{Im}Q(E_F)v_x \operatorname{Im}Q(E_F)\}$  $= \frac{L_x L_y}{2\pi l^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{v_F^2 \pi}{n^2} \exp\left(-\frac{(2n-1)(\hbar\omega_c)^2}{n^2}\right)$ 

$$=\frac{L_{x}L_{y}}{2\pi l_{c}^{2}}\cdot\frac{v_{F}^{2}\pi}{\eta^{2}}\cdot\frac{\exp\left(-\frac{(\hbar\omega_{c})^{2}}{\eta^{2}}\right)}{1-\exp\left(-\frac{2(\hbar\omega_{c})^{2}}{\eta^{2}}\right)}.$$
 (13)

令  $t = (\hbar\omega_{e})^{2} / \eta^{2} = \hbar v_{F}^{2} eB / \eta^{2}$  ,它是一个无量纲的数 , 代表朗道能级之间间隔的能量单位与准粒子谱展宽 之比的平方.

将(13) 式代入(2) 式,得到准粒子谱函数为高斯 分布时的最小电导率为

$$\sigma_{xx} = \frac{e^2}{h} \cdot \frac{te^{-t}}{1 - e^{-2t}}.$$
 (14)

从这个结果中我们可以看到,如图 1 所示,最小 电导率由参数 t 的大小决定.当外磁场趋于零时(即  $t \rightarrow 0$ ),最小电导率  $\sigma_{xx} = e^2/2h$ ,与准粒子谱函数展 宽无关,因而是普适的.如果考虑自旋和子格点简 并,那么  $\sigma_{xx} = 4 \times e^2/2h = 2e^2/h$ .当外加磁场和准粒 子谱函数展宽有限时,最小电导率随  $t \sim B/\eta^2$  的变 化而改变.当准粒子谱函数展宽趋于零时(即  $t \rightarrow \infty$ ),最小电导率  $\sigma_{xx}$ 也趋于零.



图 1 准粒子谱函数满足高斯分布时最小电导率 σ<sub>xx</sub>随 t 的变化

采用高斯分布描述准粒子谱函数得到的无外加 磁场时单层石墨片的最小电导率 2e<sup>2</sup>/h 比用洛伦兹 分布描述准粒子谱函数所得结果 4e<sup>2</sup>/πh 要大一些, 更加接近实验的结果.另外,从结果中可以看出,如 果准粒子谱函数形式满足高斯分布,那么在外磁场 趋于零的时候,杂质引起的展宽是不会影响到最小 电导率的,因而是普适的.但是当外磁场不为零的时候,最小电导率依赖于外磁场强度和杂质引起的谱 分布的展宽,这与洛伦兹分布得到的结果是截然不 同的:从(12)式中看出,如果准粒子谱函数为洛伦兹 分布时,最小电导率是不依赖于外磁场强度与杂质 引起的展宽的.从我们的计算可以看出,最小电导率 的大小及其性质依赖于准粒子谱函数的分布形式, 这还有待于实验的进一步验证.

准粒子谱函数的分布形式及其展宽代表的是杂 质散射及电子间库仑相互作用对费米面附近自由粒 子的修正.尤其在狄拉克点附近,一方面由于库仑相 互作用没有得到很好的屏蔽,另一方面由于单层石 墨片是一个严格的二维体系,热力学的涨落会引起 各种形式的缺陷,因此在狄拉克点附近的输运性质 主要是由库仑相互作用和杂质散射决定的.我们的 工作表明,准确地了解杂质散射和库仑相互作用如 何影响狄拉克点附近准粒子谱函数的性质,对进一 步理解扩散区最小电导率是至关重要的.最近的研 究表明,库仑相互作用的修正使得费米液体的概念 在狄拉克点附近是边缘的(marginal)<sup>241</sup>,因此,在狄 拉克点附近准粒子谱函数应取何种表达形式,仍需 要理论和实验更深入的研究.

#### 3.结 论

本文从久保公式出发,计算了在外加均匀磁场 情况下单层石墨片的最小电导率.研究结果表明,最 小电导率的大小及其性质依赖于准粒子谱函数的分 布形式,若采用洛伦兹分布描述准粒子谱函数,得到

- [1] Novoselov K S , Geim A K , Mozorov S V , Jiang D , Zhang Y , Dubonos S V , Gregorieva I V , Firsov A A 2004 Science 306 666
- [2] Morozov S V, Novoselov K S, Katsnelson M I, Schedin F, Ponomarenko L A, Jiang D, Geim A K 2006 Phys. Rev. Lett. 97 016801
- [3] Novoselov K S , Geim A K , Morozov S V , Jiang D , Katsnelson M I , Grigorieva I V , Dubonos S V , Firsov A A 2005 Nature 438 197
- [4] Zhang Y B , Tan Y W , Stormer Horst L , Kim Philip 2005 Nature 438 201
- [5] Titov M , Beenakker C W J 2006 Phys. Rev. B 74 041401
- [6] Heersche Hubert B, Jarillo-Herrero Pablo, Oostinga Jeroen B, Vandersypen Lieven M K, Morpurgo Alberto F 2007 Nature 446 56
- [7] Katsnelson M I , Novoselov K S , Geim A K 2006 Nat . Phys . 2 620
- [8] Sasaki K , Murakami S , Saito R 2006 Appl . Phys . Lett . 88 113110
- [9] Zheng H X , Wang Z F , Luo T , Shi Q W , Chen Jie 2007 Phys. Rev. B 75 165414
- [10] Wang Z F , Shi Q W , Li Q X , Wang X P , Hou J G , Zheng H X , Y Y , Chen J 2007 Appl . Phys. Lett. 91 053109
- [11] Pan Y , Shi D X , Gao H J 2007 Chinese Physics 16 3151

的最小电导率大小为  $4e^2/\pi h$ ,并且这一结果与外加 磁场的强弱和准粒子谱函数展宽无关;若采用高斯 分布描述准粒子谱函数,在外磁场趋于零时,其最小 电导率为  $\sigma_{xx} = 2e^2/h$ ,这一结果不依赖于准粒子谱 函数的展宽,因而是普适的,但在外磁场不为零时, 最小电导率依赖于外磁场的强弱和准粒子谱函数展 宽之比.

- [12] Abrahams E , Anderson P W , Licciardello D C , Ramakrishnan T V 1979 Phys. Rev. Lett. 42 673
- [13] Katsnelson M I 2006 Eur. Phys. J. B 51 157
- [14] Peres N M R, Guinea F, Castro Neto A H 2006 Phys. Rev. B 73 125411
- [15] Gusynin V P , Sharapov S G 2006 Phys. Rev. B 73 245411
- [16] Zheng Y , Ando T 2002 Phys. Rev B 65 245420
- [17] Cserti J 2007 Phys. Rev. B 75 033405
- [18] Ziegler K 2007 Phys. Rev. Lett. 97 266802
- [19] Ziegler K 2007 Phys. Rev. B 75 233407
- [20] Nomura K , MacDonald A H 2006 Phys. Rev. Lett. 96 256602
- [21] Miao F, Wijeratne S, Zhang Y, Coskun U C, Bao W, Lau C N 2007 Science 317 1530
- [22] Ando T , Fowler A B , Stern F 1982 Rev. Mod. Phys. 54 437
- [23] Grosso G , Parravicini G P 2006 Solid State Physics , Elsevier (Singapore)Pte Ltd. p439
- [24] Das Sarma S , Hwang E H , Tse Wang-Kong 2007 Phys. Rev. B 75 121406

## Effect of the spectral function of quasiparticle on minimal conductivity of graphene \*

Luo Tao Zhu Wei Shi Qin-Wei<sup>†</sup> Wang Xiao-Ping

( Hefei National Laboratory for Physical Sciences at Microscale , University of Science and Technology of China , Hefei 230026 , China )
 ( Received 17 October 2007 ; revised manuscript received 15 November 2007 )

#### Abstract

Under effective-mass approximation, the Kubo formula is used to calculate the minimal conductivity of graphene. It is found that the minimal conductivity depends on the spectral function of quasiparticle. If the distribution of the spectral function is taken to be Lorentz distribution, the minimal conductivity is  $4e^2/\pi h$ . If the distribution of the spectral function satisfies Gaussian distribution, however, the minimal conductivity is  $2e^2/h$ .

Keywords : graphene , minimal conductivity , Kubo formula PACC : 7125X , 7280R

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 10574119 50121202).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail : phsqw@ustc.edu.cn